

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成 18 年 8 月 24 日 (2006.8.24)

【公開番号】特開 2005-79130 (P2005-79130A)

【公開日】平成 17 年 3 月 24 日 (2005.3.24)

【年通号数】公開・登録公報 2005-012

【出願番号】特願 2003-304255 (P2003-304255)

【国際特許分類】

H 0 1 L 23/52 (2006.01)

H 0 1 L 21/3205 (2006.01)

G 0 9 F 9/30 (2006.01)

H 0 1 L 51/50 (2006.01)

H 0 5 B 33/14 (2006.01)

H 0 5 B 33/26 (2006.01)

H 0 1 L 29/786 (2006.01)

G 0 2 F 1/1343 (2006.01)

G 0 2 F 1/1345 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/88 N

G 0 9 F 9/30 3 3 0 Z

H 0 5 B 33/14 A

H 0 5 B 33/14 Z

H 0 5 B 33/26 Z

H 0 1 L 21/88 R

H 0 1 L 29/78 6 1 2 C

G 0 2 F 1/1343

G 0 2 F 1/1345

【手続補正書】

【提出日】平成 18 年 7 月 11 日 (2006.7.11)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

基板上に形成される薄膜配線層であって、Al を主成分とする主導体層と該主導体層を覆う被覆層からなり、該被覆層は、(Ti、Zr、Hf、V、Nb、Ta、Mo、W) から選択される 1 種または 2 種以上の添加元素を 3 ~ 15 原子% 含有し、残部が実質的に Ni からなる合金層であることを特徴とする薄膜配線層。

【請求項 2】

添加元素は、(V、Nb、Ta) から選択される 1 種又は 2 種以上であることを特徴とする請求項 1 に記載の薄膜配線層。

【請求項 3】

添加元素として、少なくとも Nb を 1 ~ 7 原子% 含有し、かつ Mo および / または W を Nb との合計で 3 ~ 10 原子% 含有すること特徴とする請求項 1 に記載の薄膜配線層。

【請求項 4】

ガラス基板上に形成する配線層であることを特徴とする請求項 1 乃至 3 のいずれかに記載

の薄膜配線層。